(19)日本国特許庁(JP)

(51) Int.Cl.7

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-9098

(P2002 - 9098A)

テーマコート\*(参考)

(43)公開日 平成14年1月11日(2002.1.11)

(21)出願番号	特願2000-182273(P2000-182273)	(71)出願人 000002185 ソニー株式会社				
	審査請求	未請求請求	求項の数40	OL	(全 12 頁)	最終頁に続く
16/44		H05B	33/10			
14/34			16/44		Α	
14/24			14/34	,	K	4 K 0 3 0
C 2 3 C 14/04			14/24		G	4K029
H01L 21/60		C 2 3 C	14/04		Α	3 K 0 0 7

 $\mathbf{F}$  I

(22)出願日 平成12年6月16日(2000.6.16)

識別記号

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 柿沼 正康

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(74)代理人 100067736

弁理士 小池 晃 (外2名)

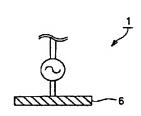
最終頁に続く

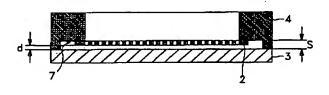
(54) 【発明の名称】 パターン形成装置、パターン形成方法、有機電界発光素子ディスプレイの製造装置及び製造方法

# (57) 【要約】

【課題】 成膜時の熱によってメタルマスクが膨張しても、メタルマスクの歪みを防いで、安定にパターン形成を行う。

【解決手段】 基板上にパターン形成を行うパターン形成装置であって、基板の一方の面側に配され、磁性材料からなるマスクと、マスクが取り付けられるマスク取り付け部材と、基板のでスクが配された面と対向して配されたパターン形成手段とを備える。そして、マスク取り付け部材は、マスクが熱膨張した場合の大きさよりも大きく、かつ、マスクの厚みよりも大きな深さで凹に形成された段差部分を有しており、マスクは当該段差部分に取り付けられる。





### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上にパターン形成を行うパターン形成装置であって、

上記基板の一方の面側に配され、磁性材料からなるマスクと、

上記マスクが取り付けられるマスク取り付け部材と、

上記基板の他方の面側に配された磁化部材と、

上記基板のマスクが配された面と対向して配されたパターン形成手段とを備え、

上記マスク取り付け部材は、上記マスクが熱膨張した場合の大きさよりも大きく、かつ、当該マスクの厚みよりも大きな深さで凹に形成された段差部分を有しており、上記マスクは当該段差部分に取り付けられることを特徴とするパターン形成装置。

【請求項2】 上記パターン形成手段が、真空蒸着によるものであることを特徴とする請求項1記載のパターン形成装置。

【請求項3】 上記パターン形成手段が、スパッタリングによるものであることを特徴とする請求項1記載のパターン形成装置。

【請求項4】 上記パターン形成手段が、化学的気相成 長によるものであることを特徴とする請求項1記載のパ ターン形成装置。

【請求項5】 上記パターン形成手段が、ドライエッチングによるものであることを特徴とする請求項1記載のパターン形成装置。

【請求項6】 基板上にパターン形成を行うパターン形成装置であって、

上記基板の一方の面側に配され、磁性材料からなるマスクと、

上記マスクが取り付けられるマスク取り付け部材と、

上記基板の他方の面側に配された磁化部材と、

上記基板のマスクが配された面と対向して配されたパターン形成手段とを備え、

上記磁化部材は、上記マスクが熱膨張した場合の大きさよりも大きく、かつ、当該マスクの厚みと上記基板の厚みとの和よりも大きな深さで凹に形成された段差部分を、基板と対向する側に有していることを特徴とするパターン形成装置。

【請求項7】 上記パターン形成手段が、真空蒸着によるものであることを特徴とする請求項6記載のパターン形成装置。

【請求項8】 上記パターン形成手段が、スパッタリングによるものであることを特徴とする請求項6記載のパターン形成装置。

【請求項9】 上記パターン形成手段が、化学的気相成長によるものであることを特徴とする請求項6記載のパターン形成装置。

【請求項10】 上記パターン形成手段が、ドライエッチングによるものであることを特徴とする請求項6記載

のパターン形成装置。

【請求項11】 基板の一方の面側に磁性材料からなるマスクを配し、基板の他方の面に磁化部材を配した状態で、パターン形成手段により当該基板の一方の面上にパターン形成を行うに際し、

上記マスク取り付け部材として、上記マスクが熱膨張した場合の大きさよりも大きく、かつ、当該マスクの厚みよりも大きな深さで凹に形成された段差部分を有するものを用い、上記マスクを当該段差部分に取り付けることを特徴とするパターン形成方法。

【請求項12】 真空蒸着法により、上記基板上にパターン形成を行うことを特徴とする請求項11記載のパターン形成方法。

【請求項13】 スパッタリング法により、上記基板上にパターン形成を行うことを特徴とする請求項11記載のパターン形成方法。

【請求項14】 化学的気相成長法により、上記基板上にパターン形成を行うことを特徴とする請求項11記載のパターン形成方法。

【請求項15】 ドライエッチング法により、上記基板上にパターン形成を行うことを特徴とする請求項11記載のパターン形成方法。

【請求項16】 基板の一方の面側に磁性材料からなるマスクを配し、基板の他方の面に磁化部材を配した状態で、パターン形成手段により当該基板の一方の面上にパターン形成を行うに際し、

上記磁化部材として、上記マスクが熱膨張した場合の大きさよりも大きく、かつ、当該マスクの厚みと上記基板の厚みとの和よりも大きな深さで凹に形成された段差部分を、基板と対向する側に有するものを用い、

パターン形成時には、上記基板と上記マスクとを上記段 差部分中に収容することを特徴とするパターン形成方 法

【請求項17】 真空蒸着法により、上記基板上にパターン形成を行うことを特徴とする請求項16記載のパターン形成方法。

【請求項18】 スパッタリング法により、上記基板上にパターン形成を行うことを特徴とする請求項16記載のパターン形成方法。

【請求項19】 化学的気相成長法により、上記基板上にパターン形成を行うことを特徴とする請求項16記載のパターン形成方法。

【請求項20】 ドライエッチング法により、上記基板上にパターン形成を行うことを特徴とする請求項16記載のパターン形成方法。

【請求項21】 基板上に、少なくとも陽極と、正孔輸送層及び発光層からなる有機層と、陰極とをパターン形成して有機電界発光素子ディスプレイとする有機電界発光素子ディスプレイの製造装置であって、

上記基板の一方の面側に配され、磁性材料からなるマス

クと、

上記マスクが取り付けられるマスク取り付け部材と、

上記基板の他方の面側に配された磁化部材と、

上記基板のマスクが配された面と対向して配されたパターン形成手段とを備え、

上記マスク取り付け部材は、上記マスクが熱膨張した場合の大きさよりも大きく、当該マスクの厚みよりも大きな深さで凹に形成された段差部分を有しており、上記マスクは当該段差部分に取り付けられることを特徴とする有機電界発光素子ディスプレイの製造装置。

【請求項22】 上記パターン形成手段が、真空蒸着によるものであることを特徴とする請求項21記載の有機電界発光素子ディスプレイの製造装置。

【請求項23】 上記パターン形成手段が、スパッタリングによるものであることを特徴とする請求項21記載の有機電界発光素子ディスプレイの製造装置。

【請求項24】 上記パターン形成手段が、化学的気相 成長によるものであることを特徴とする請求項21記載 の有機電界発光素子ディスプレイの製造装置。

【請求項25】 上記パターン形成手段が、ドライエッチングによるものであることを特徴とする請求項21記載の有機電界発光素子ディスプレイの製造装置。

【請求項26】 基板上に、少なくとも陽極と、正孔輸送層及び発光層からなる有機層と、陰極とをパターン形成して有機電界発光素子ディスプレイとする有機電界発光素子ディスプレイの製造装置であって、

上記基板の一方の面側に配され、磁性材料からなるマス クと、

上記マスクが取り付けられるマスク取り付け部材と、

上記基板の他方の面側に配された磁化部材と、

上記基板のマスクが配された面と対向して配されたパタ ーン形成手段とを備え、

上記磁化部材は、上記マスクが熱膨張した場合の大きさよりも大きく、かつ、当該マスクの厚みと上記基板の厚みとの和よりも大きな深さで凹に形成された段差部分を、基板と対向する側に有していることを特徴とする有機電界発光素子ディスプレイの製造装置。

【請求項27】 上記パターン形成手段が、真空蒸着によるものであることを特徴とする請求項26記載の有機電界発光素子ディスプレイの製造装置。

【請求項28】 上記パターン形成手段が、スパッタリングによるものであることを特徴とする請求項26記載の有機電界発光素子ディスプレイの製造装置。

【請求項29】 上記パターン形成手段が、化学的気相成長によるものであることを特徴とする請求項26記載の有機電界発光素子ディスプレイの製造装置。

【請求項30】 上記パターン形成手段が、ドライエッチングによるものであることを特徴とする請求項26記載の有機電界発光素子ディスプレイの製造装置。

【請求項31】 基板上に、少なくとも陽極と、正孔輸

送層及び発光層からなる有機層と、陰極とをパターン形成して有機電界発光素子ディスプレイとする有機電界発光素子ディスプレイとする有機電界発光素子ディスプレイの製造方法であって、

上記基板の一方の面側に磁性材料からなるマスクを配し、基板の他方の面に磁化部材を配した状態で、パターン形成手段により当該基板の一方の面上にパターン形成を行うに際し、

上記マスク取り付け部材として、上記マスクが熱膨張した場合の大きさよりも大きく、かつ、当該マスクの厚みよりも大きな深さで凹に形成された段差部分を有するものを用い、上記マスクを当該段差部分に取り付けることを特徴とする有機電界発光素子ディスプレイの製造方法。

【請求項32】 真空蒸着法により、上記基板上にパターン形成を行うことを特徴とする請求項31記載の有機電界発光素子ディスプレイの製造方法。

【請求項33】 スパッタリング法により、上記基板上にパターン形成を行うことを特徴とする請求項31記載の有機電界発光素子ディスプレイの製造方法。

【請求項34】 化学的気相成長法により、上記基板上にパターン形成を行うことを特徴とする請求項31記載の有機電界発光素子ディスプレイの製造方法。

【請求項35】 ドライエッチング法により、上記基板上にパターン形成を行うことを特徴とする請求項31記載の有機電界発光素子ディスプレイの製造方法。

【請求項36】 基板上に、少なくとも陽極と、正孔輸送層及び発光層からなる有機層と、陰極とをパターン形成して有機電界発光素子ディスプレイとする有機電界発光素子ディスプレイの製造方法であって、

上記基板の一方の面側に磁性材料からなるマスクを配し、基板の他方の面に磁化部材を配した状態で、パターン形成手段により当該基板の一方の面上にパターン形成を行うに際し、

上記磁化部材として、上記マスクが熱膨張した場合の大きさよりも大きく、かつ、当該マスクの厚みと上記基板の厚みとの和よりも大きな深さで凹に形成された段差部分を、基板と対向する側に有するものを用い、

パターン形成時には、上記基板と上記マスクとを上記段 差部分中に収容することを特徴とする有機電界発光素子 ディスプレイの製造方法。

【請求項37】 真空蒸着法により、上記基板上にパターン形成を行うことを特徴とする請求項36記載の有機電界発光素子ディスプレイの製造方法。

【請求項38】 スパッタリング法により、上記基板上にパターン形成を行うことを特徴とする請求項36記載の有機電界発光素子ディスプレイの製造方法。

【請求項39】 化学的気相成長法により、上記基板上にパターン形成を行うことを特徴とする請求項36記載の有機電界発光素子ディスプレイの製造方法。

【請求項40】 ドライエッチング法により、上記基板

上にパターン形成を行うことを特徴とする請求項36記 載の有機電界発光素子ディスプレイの製造方法。

# 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、メタルマスクを用いて、基板上にパターン形成するパターン形成装置、パターン形成方法、並びにそれらを用いた有機電界発光素 子ディスプレイの製造装置及び製造方法に関する。

## [0002]

【従来の技術】各種ディスプレイに用いられる発光素子として、近年、有機電界発光素子(以下、有機EL素子と称する)が注目を集めている。この有機EL素子は、透明基板上に陽極と、正孔輸送層及び発光層からなる有機層と、陰極とがこの順に形成されて構成される。そして、有機EL素子では、陽極一陰極間に電圧が印加されると、発光層内で電子一正孔の再結合が生じ、この際に、所定の波長を持った光が発生する。

【0003】このような有機EL素子は、各層の構成材料を基板上にパターン形成することにより製造される。このとき、有機層の劣化の問題から、フォトリソグラフィーによるパターン形成が不可能なため、基板上にマスクを密着させた状態で成膜することにより直接パターンを形成している。

【0004】基板にマスクを密着させる方法としては、例えば図14に示すように、マスク取り付け部材100に取り付けられ、磁性体からなるメタルマスク101を基板102の一方の面に設置し、この基板102の他方の面に、永久磁石又は電磁石からなる磁化部材103を設置する。そして、この磁化部材103によってメタルマスク101を吸い付け、メタルマスク101を基板102に密着させる方法が、特開平7-45662号公報に開示されている。

# [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この方法では、真空蒸着やスパッタリング等の成膜時やドライエッチング時の熱によりメタルマスク101が熱膨張で延びた場合、図15に示すようにメタルマスク101がゆがみ、基板102に対してメタルマスク101が部分的に浮いてしまうという問題が発生する。

【0006】具体的には、成膜でパターンを形成する場合には、メタルマスク101が基板102から微小に浮いた部分は成膜する粒子の回り込みによりパターンのエッジがボケたり、パターンの寸法精度が損なわれるといった問題があった。特にパターンが微細になると、メタルマスク101の製作上、メタルマスク101の厚さを薄くせざるを得ず、メタルマスク101が歪みやすくなるため、メタルマスク101の延びによる浮きの発生は大きな問題となっていた。

【0007】さらにこの方法によると、メタルマスク101と基板102とのパターンの位置合わせのときに、

メタルマスク101と基板102とが接触した状態で相対的に移動するため、すでに基板102上に膜が形成されている場合に膜にダメージを与えてしまうという大きな問題があった。

【0008】本発明は、このような従来の実情に鑑みて 提案されたものであり、成膜時の熱によってメタルマス クが膨張しても、メタルマスクの歪みを防いで、安定に パターン形成を行うことのできるパターン形成装置、パ ターン形成方法、有機EL素子の製造装置及び製造方法 を提供することを目的とする。

# [0009]

【課題を解決するための手段】本発明のパターン形成装置は、基板上にパターン形成を行うパターン形成装置であって、上記基板の一方の面側に配され、磁性材料からなるマスクと、上記マスクが取り付けられるマスク取り付け部材と、上記基板の他方の面側に配された磁化部材と、上記基板のマスクが配された面と対向して配されたパターン形成手段とを備える。そして、本発明のパターン形成装置は、上記マスク取り付け部材は、上記マスクが熟膨張した場合の大きさよりも大きく、かつ、当該マスクの厚みよりも大きな深さで凹に形成された段差部分を有しており、上記マスクは当該段差部分に取り付けられることを特徴とする。

【OO10】上述したような本発明に係るパターン形成装置では、マスク取り付け部材にマスクが熱膨張したときの大きさよりも大きな段差部分が設けられているので、パターン形成中の熱によってマスクが熱膨張し延びた場合でも、マスクの端部がマスク取り付け部材にあたることはない。これによりマスクは基板の下面に貼り付いたままであり、浮きが発生することがない。

【〇〇11】また、本発明のパターン形成装置は、基板上にパターン形成を行うパターン形成装置であって、上記基板の一方の面側に配され、磁性材料からなるマスクと、上記マスクが取り付けられるマスク取り付け部材と、上記基板の他方の面側に配された磁化部材と、上記基板のでスクが配された面と対向して配されたパターン形成手段とを備える。そして、本発明のパターン形成等置は、上記磁化部材は、上記マスクが熱膨張した場合の大きさよりも大きく、かつ、当該マスクの厚みと上記基板の厚みとの和よりも大きな深さで凹に形成された段差部分を、基板と対向する側に有していることを特徴とする。

【0012】上述したような本発明に係るパターン形成 装置では、磁化部材にマスクが熱膨張したときの大きさ よりも大きな段差部分が設けられているので、パターン 形成中の熱によってマスクが熱膨張し延びた場合でも、 マスクの端部が磁化部材にあたることはない。これによ りマスクは基板の下面に貼り付いたままであり、浮きが 発生することがない。

【〇〇13】また、本発明のパターン形成方法は、基板

の一方の面側に磁性材料からなるマスクを配し、基板の他方の面に磁化部材を配した状態で、パターン形成手段により当該基板の一方の面上にパターン形成を行うに際し、上記マスク取り付け部材として、上記マスクが熱膨張した場合の大きさよりも大きく、かつ、当該マスクの厚みよりも大きな深さで凹に形成された段差部分を有するものを用い、上記マスクを当該段差部分に取り付けることを特徴とする。

【 O O 1 4 】上述したような本発明に係るパターン形成 方法では、マスク取り付け部材にマスクが熱膨張したと きの大きさよりも大きな段差部分を設けることで、パタ ーン形成中の熱によってマスクが熱膨張し延びた場合で も、マスクの端部がマスク取り付け部材にあたることは ない。これによりマスクは基板の下面に貼り付いたまま であり、浮きが発生することがない。

【 O O 1 5 】また、本発明のパターン形成方法は、基板の一方の面側に磁性材料からなるマスクを配し、基板の他方の面に磁化部材を配した状態で、パターン形成手段により当該基板の一方の面上にパターン形成を行うに際し、上記磁化部材として、上記マスクが熱膨張した場合の大きさよりも大きく、かつ、当該マスクの厚みと上記基板の厚みとの和よりも大きな深さで凹に形成された段差部分を、基板と対向する側に有するものを用い、パターン形成時には、上記基板と上記マスクとを上記段差部分中に収容することを特徴とする。

【0016】上述したような本発明に係るパターン形成方法では、磁化部材にマスクが熱膨張したときの大きさよりも大きな段差部分が設けられているので、パターン形成中の熱によってマスクが熱膨張し延びた場合でも、マスクの端部が磁化部材にあたることはない。これによりマスクは基板の下面に貼り付いたままであり、浮きが発生することがない。

【0017】また、本発明の有機電界発光素子ディスプレイの製造装置は、基板上に、少なくとも陽極と、、陰極とをパタの表が発光層からなる有機層と、陰極とをパターであるで、上記基板の一方の面側に配され、磁性材料を取り付けられるマスクと、上記基板の他方の面側に配された磁化であるで、上記基板の他方の面側に配された磁化でありが配された面と対向して配された。上記基板のでありが配された面と対向して記述である。そして、本発明の方の関連になり、上記をでは、上記でスクが配された電界発光素子ディスプレイの製造装置した場合の大きな消失さく、当該マスクの厚みよりも大きな深さで凹に形成された段差部分を有しており、上記マスクは当該段差部分に取り付けられることを特徴とする。

【0018】上述したような本発明に係る有機電界発光 素子ディスプレイの製造装置では、マスク取り付け部材 にマスクが熱膨張したときの大きさよりも大きな段差部 分が設けられているので、パターン形成中の熱によって マスクが熱膨張し延びた場合でも、マスクの端部がマスク取り付け部材にあたることはない。これによりマスクは基板の下面に貼り付いたままであり、浮きが発生することがない。

【 O O 2 O 】上述したような本発明に係る有機電界発光素子ディスプレイの製造装置では、磁化部材にマスクが熱膨張したときの大きさよりも大きな段差部分が設けられているので、パターン形成中の熱によってマスクが熱膨張し延びた場合でも、マスクの端部が磁化部材にあたることはない。これによりマスクは基板の下面に貼り付いたままであり、浮きが発生することがない。

【〇〇21】また、有機電界発光素子ディスプレイの製造方法は、本発明の基板上に、少なくとも陽極と、正孔輸送層及び発光層からなる有機層と、陰極とをパターン形成して有機電界発光素子ディスプレイとするものであって、上記基板の一方の面側に磁性材料からなるマスクを配し、基板の他方の面に磁化部材を配した状態で、パターン形成手段により当該基板の一方の面上にパターン形成を行うに際し、上記マスク取り付け部材として、かいのででは、上記マスクが熱膨張した場合の大きさよりも大きく、かいて段差部分を有するものを用い、上記マスクを当該段差部分に取り付けることを特徴とする。

【〇〇22】上述したような本発明に係る有機電界発光素子ディスプレイの製造方法では、マスク取り付け部材にマスクが熱膨張したときの大きさよりも大きな段差部分を設けることで、パターン形成中の熱によってマスクが熱膨張し延びた場合でも、マスクの端部がマスク取り付け部材にあたることはない。これによりマスクは基板の下面に貼り付いたままであり、浮きが発生することがない。

【 O O 2 3 】また、本発明の有機電界発光素子ディスプレイの製造方法は、基板上に、少なくとも陽極と、正孔輸送層及び発光層からなる有機層と、陰極とをパターン形成して有機電界発光素子ディスプレイとするものであ

って、上記基板の一方の面側に磁性材料からなるマスクを配し、基板の他方の面に磁化部材を配した状態で、パターン形成手段により当該基板の一方の面上にパターン形成を行うに際し、上記磁化部材として、上記マスクが 熱膨張した場合の大きさよりも大きく、かつ、当該マスクの厚みと上記基板の厚みとの和よりも大きな深さで凹に形成された段差部分を、基板と対向する側に有するものを用い、パターン形成時には、上記基板と上記マスクとを上記段差部分中に収容することを特徴とする。

【 O O 2 4 】上述したような本発明に係る有機電界発光素子ディスプレイの製造方法では、磁化部材にマスクが 熱膨張したときの大きさよりも大きな段差部分を設ける ことで、パターン形成中の熱によってマスクが熱膨張し 延びた場合でも、マスクの端部が磁化部材にあたること はない。これによりマスクは基板の下面に貼り付いたままであり、浮きが発生することがない。

[0025]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について説明する。

【0026】本実施の形態に係るパターン形成装置1は、図1に示すように、メタルマスク2を用いたパターン成膜により、基板3上に所定パターンを形成するものであり、磁性体からなるメタルマスク2を設置するマスク取り付けベース4と、磁力によりメタルマスク2を基板3上に保持固定する磁化部材5と、成膜手段6とを備える。

【〇〇27】メタルマスク2は、例えばFeとNiの合金である42アロイ(FeNi₃)や、FeとCoの合金をはじめとする種々の強磁性体材料からなる。その中でも、基板3と熱膨張係数の近い材料を用いることが好ましい。そして、このメタルマスク2には、基板3上に形成するパターンに応じた形状の開口部が形成されている。

【0028】マスク取り付けベース4は、その外径がメタルマスク2の外形と略相似形で、当該メタルマスク2よりも大きな中空筒状に形成されている。

【0029】そして、このマスク取り付けベース4には、基板3と対向する側に、段差sを有する段差部分7が凹に設けられている。メタルマスク2は、この段差部分7に取り付けられる。段差部分7に配されたメタルマスク2は、当該マスク取り付けベース4の中空部分を覆い塞ぐかたちとなる。

【0030】ここで、段差部分7の段差sは少なくともメタルマスク2の厚さよりも大きいことが必要である。基板3とメタルマスク2とのパターン合わせをする際や、成膜手段6により成膜を行う際には、メタルマスク2は、マスク取り付けベース4の段差部分7と基板3で囲まれることとなる。

【0031】具体的には、メタルマスク2が設置されたマスク取り付けベース4上に基板3が配された場合に、

メタルマスク2と基板3との間の隙間 d が、0.01mm以上、0.5mm以下の範囲、より好ましくは0.01mm以上、0.1mm以下の範囲に確保されることが好ましい。

【0032】メタルマスク2と基板3との間の隙間dが O. O1mmよりも小さいと、後述するように基板3と メタルマスク2とのパターン合わせをする際に、基板3 とメタルマスク2とが接触してしまうおそれがある。基 板3とメタルマスク2とが接触してしまうと、既に基板 3上に形成されているパターンが傷ついてしまう。ま た、メタルマスク2と基板3との間の隙間 dが0.5m mよりも大きい場合には、基板3とメタルマスク2との パターン合わせが正常に行われていても、図2に示すよ うに、磁化部材5によってメタルマスク2を基板3の下 面に引き寄せるときに、パターンの位置ずれを生じてし まうおそれがある。従って、メタルマスク2と基板3と の間の隙間 d が、 O . O 1 mm以上、 O . 5 mm以下の ... 範囲とすることで、基板3上に既に形成されているパタ ーンを傷つけることなく、基板3とメタルマスク2との パターン合わせを安定してほぼ確実に行うことができ る。なお、図2及び図3では、パターン形成装置1のう ち、マスク機構の部分のみを抜き出して示している。 【0033】また、段差部分7の外形は、メタルマスク

【0033】また、段差部分7の外形は、メダルマスク2よりも大きいことが必要である。具体的には、図3に示すように、段差部分7の幅wは、成膜時の熱により熱膨張した状態のメタルマスク2の大きさよりも大きくなされていることが必要である。段差部分7の幅wが、成膜時の熱により熱膨張した状態のメタルマスク2の大きさよりも小さい場合には、成膜時の熱により熱膨張したメタルマスク2が、段差部分7の壁にあたって波状に浮き上がってしまい、本発明の目的を達成することができない。

【0034】また、図示しないが、マスク取り付けべース4には、メタルマスク2のパターンと基板3にすでに形成されているパターンとの位置合わせのために、基板3の位置を調整するアライメント機構が設けられている

【0035】磁化部材5は永久磁石や電磁石等からなり、図示しない保持機構によって基板3の上記メタルマスク2が配される面とは反対側の面に保持されている。この保持機構によって、磁化部材5は、成膜時には基板3上に密着して配される。また、成膜しない時には基板3とは離された状態で配されることになる。

【0036】成膜手段6としては、とくに限定されるものではなく、真空蒸着手段、スパッタリング手段、CVD(化学的気相成長)手段等が挙げられる。図1中では、成膜手段6として真空蒸着手段を挙げている。

【0037】なお、本発明は成膜のみに限定されず、メタルマスク2を用いて所定形状にパターンを形成するものであれば、メタルマスク2を用いて成膜しパターンを

形成する場合のほか、成膜後にメタルマスク2を用いて ドライエッチングすることによりパターンを形成する場 合にも適用される。

【0038】そして、このようなパターン形成装置1を用いて、基板3上に所定のパターン形成を行う場合には、まず始めにマスクアライメントを行う。

【0039】このとき、磁化部材5は基板3から離しておく。そしてマスク取り付けベース4に設けられた段差部分7の中にメタルマスク2を設置する。さらに基板3をマスク取り付けベース4上に設置する。

【0040】すると図1に示すように、基板3とメタルマスク2との間には隙間 d が生じることになる。この状態で図示しないアライメント機構によって基板3の位置を調整し、メタルマスク2のパターンと基板3に既に作製されているパターンとの位置合わせ(マスクアライメント)を行う。

【0041】このとき、メタルマスク2と基板3との間の隙間 dが、0.01mm以上、0.5mm以下の範囲に確保されているので、基板3上に既に形成されているパターンを傷つけることなく、基板3とメタルマスク2とのパターン合わせを安定してほぼ確実に行うことができる。

【0042】マスクアライメントが終了したら、磁化部材5を移動させ、基板3の上に磁化部材5を設置する。すると、図2に示すように、磁性体材料からなるメタルマスク2は、基板3を介した磁化部材5の磁気作用によって引きつけられ、基板3の一方の面に貼り付くことになる。ここでメタルマスク2の端面とマスク取り付けベース4の段差の端面との間には隙間eが確保されている。

【0043】この状態で真空蒸着法等、上述したような成膜法により成膜を行う。なお、基板3の全面に成膜した後、ドライエッチングによりパターンを形成する方法でもよい。このとき、磁化部材5の磁気作用によって、磁性材料からなるメタルマスク2はその全体が基板3に密着されて基板3から浮き上がることがない。

【0044】さらに、成膜中の熱によってメタルマスク2が熱膨張し延びるが、メタルマスク2の周辺部には隙間 e が確保されているため、メタルマスク2の端部がマスク取り付けベース4にあたることはない。したがってメタルマスク2は基板3の下面に貼り付いたままであり、メタルマスク2と基板3との間に浮きが発生することがない。これにより、位置ずれやぼけが発生することなく、安定して基板3上にパターンを形成することができる。

【0045】なお、上述した実施の形態では、成膜手段6として真空蒸着によるものを例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、スパッタリング、CVD等、他の方法であっても構わない。また、本発明は成膜のみに限定されず、メタルマスク2を用いて

所定形状にパターンを形成するものであれば、メタルマスク2を用いて成膜しパターンを形成したり、成膜後にメタルマスク2を用いてドライエッチングすることによりパターンを形成する際に使用することができる。

【0046】そして、上述したような本実施の形態に係るパターン形成装置1は、有機電界発光素子(以下、有機EL素子と称する)から構成された多数の画素を備えてなる有機ELディスプレイを製造する際の製造装置として適用されるときに、特に好適である。

【0047】本発明を適用して製造される有機ELディスプレイの一構成例を図4及び図5に示す。この有機ELディスプレイ20は、透明基板21上に、陽極となる透明電極22をストライプ状に形成し、さらに、正孔輸送層と発光層とからなる有機層23を透明電極22と直交するように形成し、有機層23上に陰極24を形成してよって、透明電極22と陰極24とが交差する位置にそれぞれ有機EL素子を形成してこれら有機EL素子を形成してこれら有機EL素子を縦横に配置した発光エリアAを形成し、また、その周部に、発光エリアを外部回路又は内部駆動回路に接続させるための取り出し電極部Bを形成している。

【0048】なお、図示しないものの、このような有機 ELディスプレイ20においては、通常、透明電極22 間に絶縁層が設けられており、これによって透明電極2 2間の短絡、さらには透明電極22と陰極24との間の 短絡が防止されている。

【0049】このような有機ELディスプレイ20において、透明電極22と陰極24とが交差する位置に構成される有機EL素子としては、例えば図6に示すシングルヘテロ型の有機EL素子27がある。この有機EL素子27は、ガラス基板等の透明基板21上にITO(Indium tin oxide)等の透明電極22からなる陽極が設けられ、その上に正孔輸送層23a及び発光層23bからなる有機層23、アルミニウム等からなる陰極24が、この順に設けられることにより構成されたものである。

【0050】そして、このような構成のもとに有機EL素子27は、陽極に正の電圧、陰極24に負の電圧が印加されると、陽極から注入された正孔が正孔輸送層23 aを経て発光層23bに、また陰極24から注入された電子が発光層23bにそれぞれ到達し、発光層23b内で電子一正孔の再結合が生じる。このとき、所定の波長を持った光が発生し、図6中矢印で示すように透明基板21側から外に出射する。

【0051】上述したような構成の有機ELディスプレイ20の製造方法の一例を以下に説明する。図7~図10は有機ELディスプレイ20の製造方法を順に説明するための要部側断面図であり、特に図5中のC-C線斜視断面図である。

【0052】まず、図7に示すように、透明基板21上に透明導電材料、例えば1TOをパターン成膜することにより、ストライプ状の透明電極22を形成する。

【0053】次に、これら透明電極22を覆った状態で透明基板21上に絶縁材料を形成し、さらにこれをパターニングして図8に示すように透明電極22上に開口部25を有する絶縁膜26を得る。次いで、真空蒸着によって透明基板21上の全面に有機層23用の有機材料を成膜し、これにより図9に示すように絶縁層上を覆うと共に上記開口部25においては透明基板21上面に当接する有機層23を形成する。

【0054】続いて、上記有機層23上に導電材料を例えば真空蒸着法によって成膜し、導電膜(図示略)を形成する。その後、上記有機層23と導電膜とを同じマスクを用いて連続してパターニングし、図10に示すように、透明電極22に直交するストライプ状の陰極24、及び有機層23を積層した状態で並列して形成する。そして、陰極24を覆って絶縁層(図示略)等を形成することによって、図4及び図5に示したような有機ELディスプレイ20が得られる。

【〇〇55】有機EL素子を構成する各構成膜をパターニング形成する際に、上述したような本実施の形態に係るパターン形成装置1を製造装置として用いれば、成膜中の熱によってメタルマスク2が熱膨張し延びても、メタルマスク2の端部がマスク取り付けベース4にあたることはない。したがってメタルマスク2は基板3の下面に貼り付いたままであり、メタルマスク2と基板3との間に浮きが発生することがない。これにより、位置ずれやぼけが発生することなく、安定して基板上に構成膜をパターニング形成することができる。

【0056】したがって、本発明に係るパターン形成装置1を有機EL素子ディスプレイの製造装置として用いて有機EL素子を製造することで、パターンの位置ずれやぼけに起因する不良品の発生を低減して、製造歩留まりを向上することができる。

【0057】なお、上述した例では、マトリクスタイプの有機ELディスプレイについての製造装置及び製造方法を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されず、種々のディスプレイモジュールの製造装置及び製造方法に適用することができる。

【0058】〈第2の実施の形態〉本実施の形態に係るパターン形成装置30の一構成例を図11に示す。なお、図11では、パターン形成装置30のうち、本発明の特徴となるマスク機構の部分のみを抜き出して示している。

【0059】本実施の形態に係るパターン形成装置30も、上述した第1の実施の形態で説明したパターン形成装置1と同様に、メタルマスク31を用いたパターニング成膜により、基板32上に所定パターンで成膜を行うものであり、磁性体からなるメタルマスク31を設置するマスク取り付けベース33と、磁力によりメタルマスク31を基板32上に保持固定する磁化部材34と、図示しない成膜手段とを備える。

【0060】メタルマスク31は、例えば $Fe \ge N$ iの合金である42アロイ( $FeNi_3$ )や、 $Fe \ge Co$ の合金をはじめとする種々の強磁性体材料からなる。その中でも、基板32と熱膨張係数の近い材料を用いることが好ましい。そして、このメタルマスク31には、基板32上に形成するパターンに応じた形状の開口部が形成されている。

【0061】マスク取り付けベース33は、その外形がメタルマスク31の外形と略同形で、当該メタルマスク31よりも大きな中空筒状に形成されている。メタルマスク31は、当該マスク取り付けベース33の中空部分を覆い塞ぐように、このマスク取り付けベース33に取り付けられる。また、図示しないが、マスク取り付けベース33には、メタルマスク31のパターンと基板32にすでに形成されているパターンとの位置合わせのために、基板32の位置を調整するアライメント機構が設けられている。

【0062】磁化部材34は、永久磁石や電磁石等からなり、図示しない保持機構によって基板32の上方に保持されている。この保持機構によって、磁化部材34は、成膜時には基板32上に密着して配される。また、成膜しない時には基板32とは離された状態で配されることになる。

【0063】そして、この磁化部材34には、基板32と対向する側に、段差sを有する段差部分35が凹に設けられている。

【0064】ここで、段差部分35の段差sは少なくとも基板32の厚みとメタルマスク31の厚みとの和よりも大きいことが必要である。図12にも示すように、成膜を行う際には、基板32及びメタルマスク31は、マスク取り付けベース33と磁化部材34とで囲まれることとなる。

【0065】しかし、メタルマスク31の厚みと基板32の厚みとの和よりも、段差部分35の段差sが大きすぎると、基板32とメタルマスク31とのパターン合わせが正常に行われていても、磁化部材34によってメタルマスク31と基板32とを引き寄せるときに、パターンの位置ずれを生じてしまうおそれがある。具体的には、段差部分35の段差sは、メタルマスク31の厚みと基板32の厚みとの和よりも、0.5mm以下の範囲、より好ましくは0.01mm以上、0.1mm以下の範囲だけ大きいことが好ましい。

【0066】また、段差部分35の幅wは、メタルマスク31よりも大きいことが必要である。具体的には、図13に示すように、段差部分35の幅wは、成膜時の熱により熱膨張した状態のメタルマスク31の大きさよりも大きくなされていることが必要である。段差部分35の幅wが、成膜時の熱により熱膨張した状態のメタルマスク31の大きさよりも小さい場合には、成膜時の熱により熱膨張したメタルマスク31が、段差部分35の壁

にあたって波状に浮き上がってしまい、本発明の目的を · 達成することができない。

【0067】成膜手段としては、とくに限定されるものではなく、真空蒸着手段、スパッタリング手段、CVD(化学的気相成長)手段等が挙げられる。なお、本発明はこれに限定されるものではなく、スパッタリング、CVD等、他の方法であっても構わない。また、本発明は成膜のみに限定されず、メタルマスク31を用いて所定形状にパターンを形成するものであれば、メタルマスク31を用いて成膜しパターンを形成する場合のほか、成膜後にメタルマスク31を用いてドライエッチングすることによりパターンを形成する場合にも適用される。

【0068】そして、このようなパターン形成装置30を用いて、基板32上に所定のパターンで成膜を行う場合には、まず始めにマスクアライメントを行う。

【0069】このとき、磁化部材34は基板32から離しておく。まずマスク取り付けベース33にメタルマスク31を設置する。さらに基板32をマスク取り付けベース33上に設置する。この状態で図示しないアライメント機構によって基板32の位置を調整し、メタルマスク31のパターンと基板32に既に作製されているパターンとの位置合わせ(マスクアライメント)を行う。

【0070】マスクアライメントが終了したら、磁化部材34を移動させて、マスク取り付けベース33上に配されたメタルマスク31と基板32とを、当該段差部分35で覆い囲む。すると、図12に示すように、磁性体材料からなるメタルマスク31は、基板32を介した磁化部材34の磁気作用によって基板32ともに上方に引きつけられ、磁化部材34の段差部分35の底面に貼り付くことになる。すると、メタルマスク31とマスク取り付けベース33との間には隙間 dが生じるとともに、メタルマスク31の端面と磁化部材34の段差部分35の端面との間には隙間 e が確保される。

【0·071】この状態で真空蒸着法あるいはスパッタリング法により成膜を行う。このとき、磁化部材34の磁気作用によって、磁性材料からなるメタルマスク31はその全体が基板32に密着されて基板32から浮き上がることがない。

【0072】さらに、成膜中の熱によってメタルマスク31が熱膨張し延びるが、図13に示すように、メタルマスク31と磁化部材34との間には隙間eが確保されているため、メタルマスク31の端部が磁化部材34にあたることはない。したがってメタルマスク31は基板32の面上に貼り付いたままであり、メタルマスク31と基板32との間に浮きが発生することがない。これにより、位置ずれやぼけが発生することなく、安定して基板32上にパターンを形成することができる。

【0073】そして、上述したような本実施の形態に係るパターン形成装置30は、第1の実施の形態で例に挙げたパターン形成装置1と同様に、有機EL素子から構

成された多数の画素を備えてなる有機ELディスプレイ20を製造する際の製造装置として適用されるときに、特に好適である。

【 O O 7 4 】有機 E L 素子を構成する各構成膜をパターニング形成する際に、本実施の形態に係るパターン形成装置3 O を製造装置として用いれば、成膜中の熱によってメタルマスク3 1 が熱膨張し延びても、メタルマスク3 1 の端部が磁化部材3 4 にあたることはない。したがってメタルマスク3 1 は基板3 2 の一方の面に貼り付いたままであり、メタルマスク3 1 と基板3 2 との間に浮きが発生することがない。これにより、位置ずれやぼけが発生することなく、安定して透明基板3 2 上に構成膜をパターニング形成することができる。

【0075】したがって、本発明に係るパターン形成装置30を有機EL素子ディスプレイ20の製造装置として用いて有機EL素子ディスプレイ20を製造することで、パターンの位置ずれやぼけに起因する不良品の発生を低減して、製造歩留まりを向上することができる。

[0076]

【発明の効果】本発明では、マスク取り付け部材又は磁化部材にマスクが熱膨張したときの大きさよりも大きな段差部分を設けることで、パターン形成中の熱によってマスクが熱膨張し延びた場合でも、マスクの端部がマスク取り付け部材又は磁化部材にあたることはない。これによりマスクは基板の下面に貼り付いたままであり、浮きが発生することがない。これにより、位置ずれやぼけが発生することなく、安定して基板上にパターンを形成することができる。そして、本発明は、有機EL素子の製造に適用されるときに特に好適である。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るパターン形成装置の一構成例を示す断面図である。

【図2】図1に示されるマスク取り付けベースを用いて 成膜するときの様子を示す断面図である。

【図3】図1に示されるマスク取り付けベースを用いて 成膜するときの様子を示す断面図であり、メタルマスク が熱膨張した状態を示す断面図である。

【図4】本発明を適用して製造される有機ELディスプレイの一構成例を示す斜視図である。

【図5】本発明を適用して製造される有機ELディスプレイの一構成例を示す平面図である。

【図6】図4及び図5に示す有機ELディスプレイに採用されている有機EL素子の一構成例を示す断面図である。

【図7】有機ELディスプレイの製造方法を説明する図であり、透明基板上に透明電極をパターン形成した状態を示す断面図である。

【図8】有機ELディスプレイの製造方法を説明する図であり、透明電極上に絶縁膜をパターン形成した状態を示す断面図である。

【図9】有機ELディスプレイの製造方法を説明する図であり、絶縁層上に有機材料を成膜した状態を示す断面図である。

【図10】有機ELディスプレイの製造方法を説明する 図であり、陰極及び有機層を積層した状態で並列して形成した状態を示す断面図である。

【図11】本発明に係るパターン形成装置の他の一構成例を示す断面図である。

【図12】図11に示されるマスク取り付けベースを用いて成膜するときの様子を示す断面図である。

【図13】図11に示されるマスク取り付けベースを用

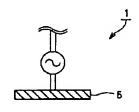
いて成膜するときの様子を示す断面図であり、メタルマスクが熱膨張した状態を示す断面図である。

【図14】従来のパターン形成方法を説明する断面図である。

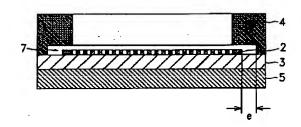
【図15】従来のパターン形成方法を説明する図であり、マスクが熱膨張した状態を示す断面図である。 【符号の説明】

1 パターン形成装置、 2 メタルマスク、 3 基 板、 4 マスク取り付けベース、 5 磁化部材、 6 成膜手段、 7, 8, 9 水路

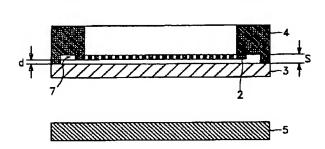
【図1】

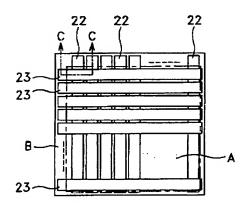


【図2】

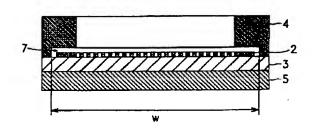


【図5】

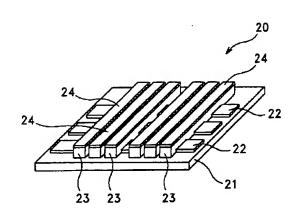


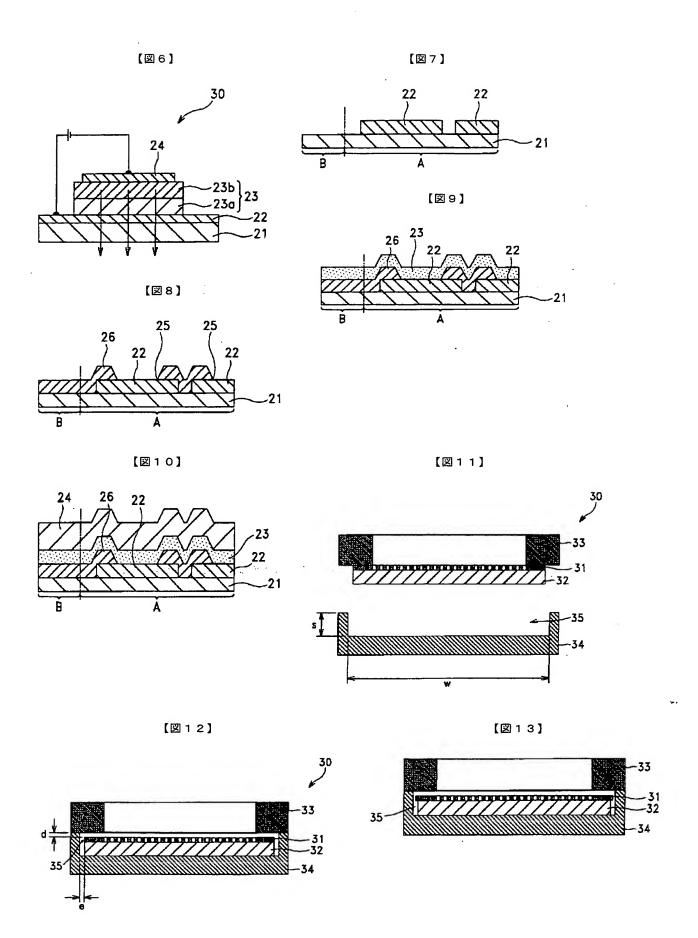


[図3]

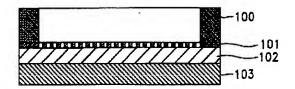


【図4】

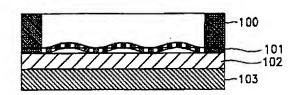




【図14】



【図15】



フロントページの続き

織別記号

FΙ

H O 5 B 33/14 H O 1 L 21/92

A 604A

HO5B 33/10

33/14 Fターム(参考) 3K007 AB18 BA06 CA01 CB01 DA01

DB03 EB00 FA01

4K029 AA09 AA24 BA10 BA14 BA50

BA62 BB02 BB03 BC09 CA01

CA05 HA02 HA03 HA04

4K030 BA11 BA16 BA42 BA45 BA61

BB12 BB14 CA06 CA17 DA05

KA24

12